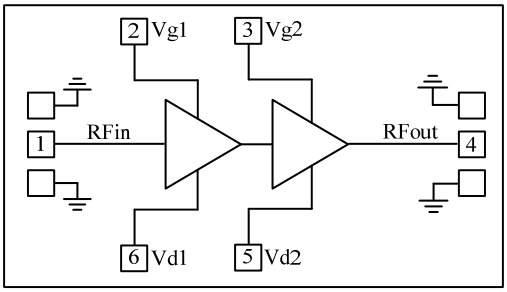
性能特点

- 频率范围：2.1GHz～2.5GHz
- 三阶交调：-38 dBc@33dBm
- 输出功率 33dBm 的附加效率：20%
- 输出功率 33dBm 的功率增益：26.5dB
- +28V@0.4A(静态)
- 芯片尺寸：2.33mm×2.71mm×0.10mm

功能框图



产品简介

NC116234C-2125P2 是一款基于 GaN HEMT 晶体管实现的高线性功率放大器芯片，采用 GaN 功率 MMIC 工艺制作，工作频率范围覆盖 2.1GHz～2.5GHz，输出功率 33dBm 时三阶交调-38 dBc,功率增益大于 26.5dB，附加效率 20%,可在脉冲和连续波（工作电压降额）模式下工作。芯片通过背面通孔接地，双电源工作，典型工作电压 Vd=+25V，Vg=-2.3V。该芯片主要应用于微波通讯等。

直流电参数（T_A = +25℃）

指标	符号	最小值	典型值	最大值	单位
栅极工作电压	Vg	-1.6	-2.3	-2.5	V
漏极工作电压	Vd	20	25	32	V
静态漏极电流	Id	0.3	0.4	0.7	A
动态漏极电流	Idd	-	0.4	5	A
静态栅极电流	Ig	-	0.1	1	mA
动态栅极电流	Igg	-	1.5	3	mA

微波电参数（T_A = +25℃，Vd = +28V，Vg = -2.0V）

指标	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	f	2.1～2.5			GHz
饱和输出功率	Psat	-	39.2	-	dBm
功率增益	Gp	26.0	26.2	27.2	dB
功率增益平坦度	△Gp	-	-	±0.6	dB
输出功率 33dBm 的附加效率	PAE	19	20	-	%
线性增益	Gain	27.1	27.5	28.7	dB
线性增益平坦度	△Gain	-	-	±0.8	dB
三阶交调 [3]	IM_3	-	39	-	dBc
输入驻波	VSWR(in)	-	1.3	1.5	-

注：1）芯片均经过在片 100% 直流测试，100% 射频测试；

2）除特殊说明外，该手册的曲线测试条件均为：Vd=+28V，Vg=-2.3V，P_{in}=13dBm

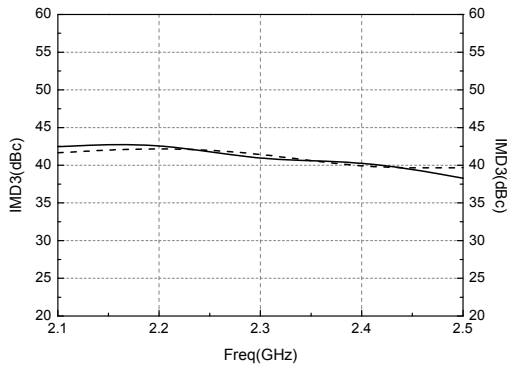
3）Vd=+25V，Vg=-2.3V，P_{out}=33Bm，外围需要加不同容值电容。

使用限制参数

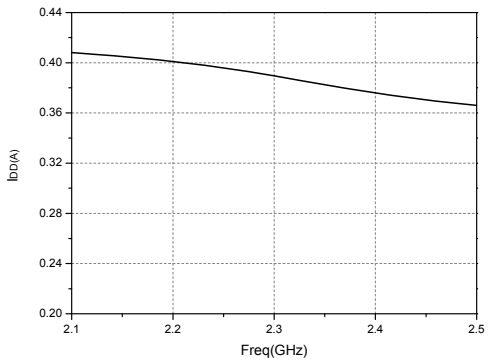
参数	符号	极限值
最大漏源电压	Vd	+35V
最大栅源电压	Vg	-6V
最高输入功率（CW）	P_p	+25dBm
储存温度	T_{STG}	-65℃～+150℃
最高工作沟道温度	T_{op}	+200℃
负载阻抗失配（抗烧毁）	Z_0	6：1

典型曲线（Vd=+25V，Vg=-2.3V）

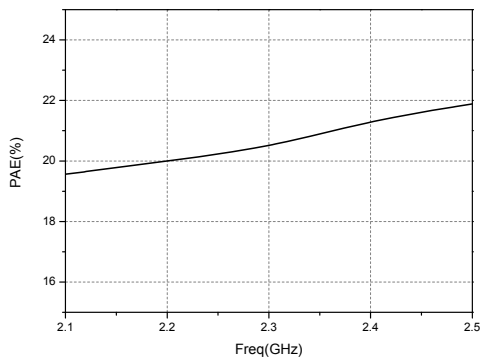
三阶交调 vs.频率



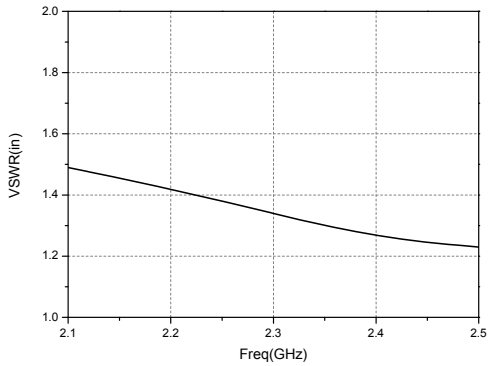
动态漏极电流 vs.频率



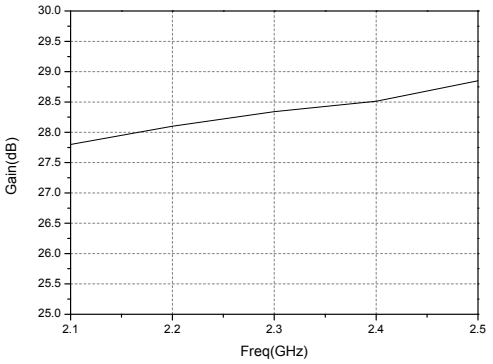
效率 vs.频率



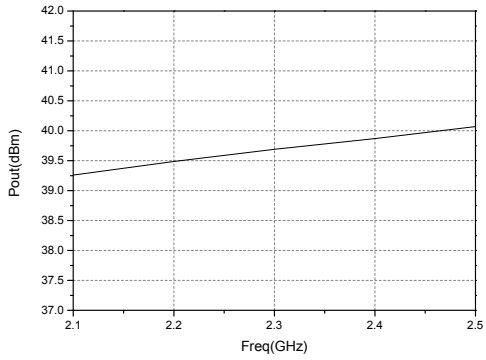
输入驻波 vs.频率（P_{in}=-10dBm）



小信号增益 vs.频率

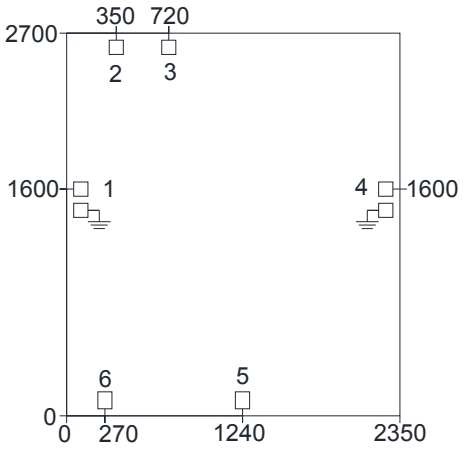


饱和输出功率 vs.频率



外形尺寸

NC116234C-2125P2 外形尺寸

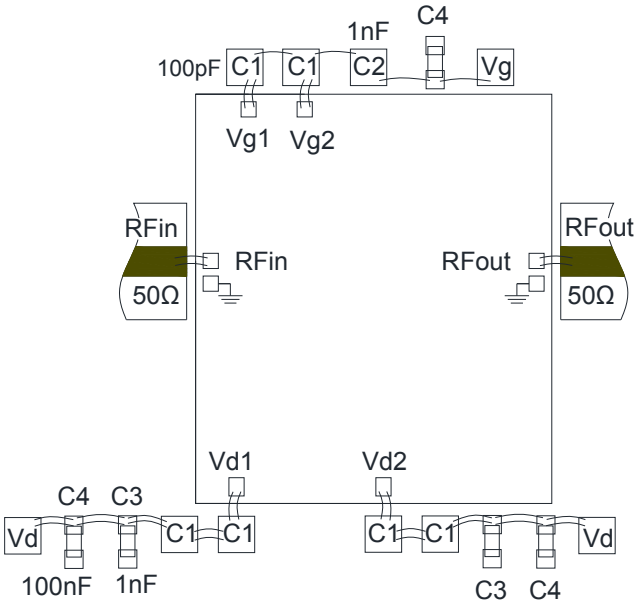


注：图中单位均为微米(μm)；
外形尺寸公差±100μm。

压点排列图

序列号	符号	功能	尺寸
1	RFin	输入压点	100×100μm^2
2	Vg1	栅极键合压点	100×100μm^2
3	Vg2	栅极键合压点	100×100μm^2
4	RFout	输出压点	100×100μm^2
5	Vd1	漏极键合压点	100×120μm^2
6	Vd2	漏极键合压点	100×120μm^2

建议装配图



注：1）外围电容的容值为 C1=100pF,C2=1nF 推荐使用单层陶瓷电容，其中 C 应尽量靠近芯片，不要超过 750μm。C3 为 0603 电容 1nF，C4 为 0603 电容 100nF

2）Ku 频段及以下功率电路微带线可采用 200μm～300μm 厚陶瓷烧结在载体上，简化装配工艺。Ku 频段及以上考虑 125μm～250μm 的低损低介电常数材料微带线粘接/烧结在载体上，以降低传输损耗，输入输出键合金丝长度控制在 350μm±150μm 以内。

注意事项

1） 单片电路需贮存在干燥洁净的 N_2 环境中；
2） 芯片衬底材料 6H-SiC 很脆，使用时必须小心，以免损伤芯片；
3） 芯片表面没有绝缘保护层，需注意装配环境洁净度，避免表面过度沾污；
4） 载体的热膨胀系数应与 6H-SiC 接近，线热膨胀系数 4.2×10^{-6}/℃,建议载体材料选用 CuMoCu 或 CuMo 或 CuW；
5） 装配时芯片与载体之间要避免孔洞，同时保证盒体和载体的良好散热；
6） 建议用金锡焊料烧结，Au:Sn=80%:20%,烧结温度不超过 300℃，时间不长于 30 秒，烧结工艺避免温度快速变化，需要逐步升降温；
7） 建议使用直径 25μm～30μm 金丝，键合台底盘温度不超过 250℃，键合时间尽量短，键合工艺避免温度快速变化；
8） 上电时先加栅压后加漏压，去电时先降漏压后降栅压；
9） 芯片内部输入输出有隔直电容，但输入端有直流对地短路结构；
10）芯片使用、装配过程中注意防静电，戴接地防静电手镯，烧结、键合台接地良好；
11）可提供 QF087 型金属陶瓷管壳封装产品；
12）有问题请与供货商联系。

该产品对静电较敏感
使用中请注意防静电